

**2Т3158А-2**  
кремниевый биполярный  
эпитаксиально-планарный  
п-р-п транзистор

### Назначение

Кремниевый эпитаксиально-планарный импульсный бескорпусный п-р-п транзистор 2Т3158А-2. Предназначен для применения в составе специальных гибридных интегральных микросхем, блоков и аппаратуры.

### Обозначение технических условий

- аАО.339.563 ТУ

### Корпусное исполнение

- бескорпусное исполнение

### Диапазон температур

- диапазон рабочих температур от - 60 до + 125 °С

**Таблица 1. Основные электрические параметры 2Т3158А-2 при  $T_{\text{окр. среды}} = 25\text{ °С}$**

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора, мкА, при $U_{\text{КБ}} = 50\text{ В}$	$I_{\text{КБО}}$	-	5
Обратный ток эмиттера, мкА, при $U_{\text{ЭБ}} = 4\text{ В}$	$I_{\text{ЭБО}}$	-	5
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, при $U_{\text{КБ}} = 5\text{ В}$ , $I_{\text{Э}} = 200\text{ мА}$ , $Q \geq 100$ , $\tau_n \leq 30\text{ мкс}$	$h_{21Э}$	50	180
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте, при $U_{\text{КЭ}} = 2\text{ В}$ , $I_{\text{К}} = 30\text{ мА}$ , $f = 10^8\text{ Гц}$	$ h_{21Э} $	2	-
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, при $I_{\text{К}} = 150\text{ мА}$ , $I_{\text{Б}} = 15\text{ мА}$ , $Q \geq 100$ , $\tau_n \leq 30\text{ мкс}$	$U_{\text{КЭ нас}}$	-	0,8
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, при $I_{\text{К}} = 150\text{ мА}$ , $I_{\text{Б}} = 15\text{ мА}$ , $Q \geq 100$ , $\tau_n \leq 30\text{ мкс}$	$U_{\text{БЭ нас}}$	-	1,5
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, нс, при $U_{\text{КБ}} = 5\text{ В}$ , $I_{\text{Э}} = 5\text{ мА}$ , $f = 5 \cdot 10^6\text{ Гц}$	$\tau_{\text{К}}$	-	400
Емкость коллекторного перехода, пФ, при $U_{\text{КБ}} = 10\text{ В}$ , $f = 10^7\text{ Гц}$	$C_{\text{К}}$	-	15
Емкость эмиттерного перехода, пФ, при $U_{\text{ЭБ}} = 0$ , $f = 10^7\text{ Гц}$	$C_{\text{Э}}$	-	40
Время рассасывания, нс, при $I_{\text{К}} = 50\text{ мА}$ , $I_{\text{Б1}} = I_{\text{Б2}} = 5\text{ мА}$ , $\tau_n \leq 30\text{ мкс}$ , $Q \geq 50$	$t_{\text{рас}}$	-	70

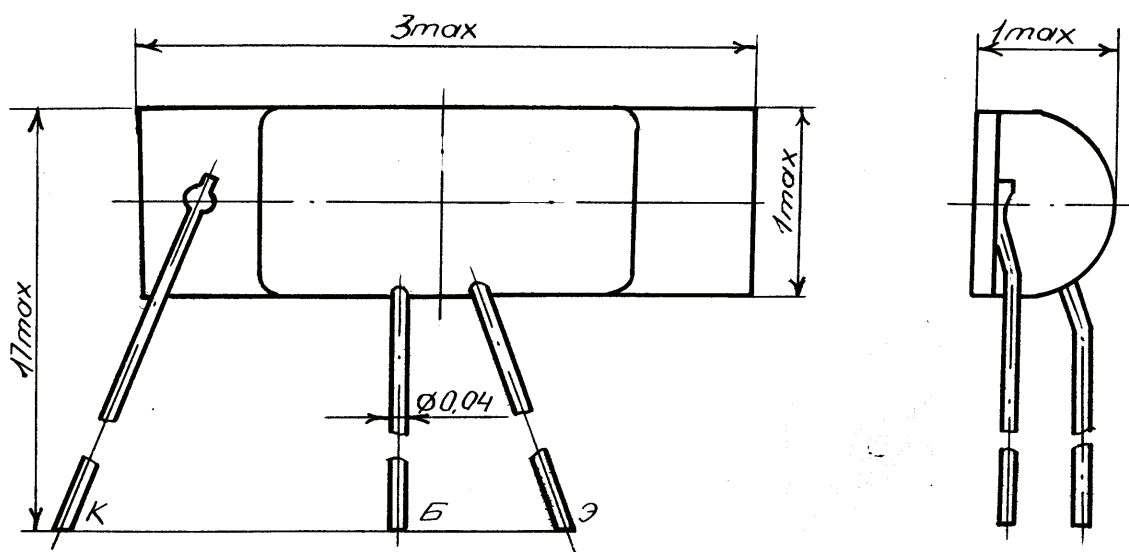


Рисунок 1. Габаритные размеры 2Т3158А-2



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>